









	<h2 style="color: red;">FDP054N10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP054N10</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p> <p>Datenblätter:  FDP054N10.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30129 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP054N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30129 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 120A (Tc) 263W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	263W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	203nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13280pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP054N10 ist neu im Original, Suche FDP054N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP054N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP054N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP050AN06AO FSC FDP050AN06AO FSC</p>	 <p>FDP060AN08AO FSC FDP060AN08AO FSC</p>	 <p>FDP053N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A TO-220</p>	 <p>FDP058N10 FSC FDP058N10 FSC</p>
 <p>FDP053N08B FSC FDP053N08B FSC</p>	 <p>FDP054N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p>	 <p>FDP060AN08AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FDP032N08B	↔ FDP036N10A	⇒ FDP036N10A	D FDP038AN06AO	↔ FDP038AN06AO
⊣ FDP038AN06AO	⊛ FDP039N08B	D FDP040N06	⇒ FDP040N06	↔ FDP045N10A
⊛ FDP045N10A	⊣ FDP047AN08	⊛ FDP047AN08AO	↔ FDP047AN08AO	↔ FDP047AN08AO
D FDP047N08	⊛ FDP047N08	⊣ FDP047N08AO	⊛ FDP047N10	↔ FDP047N10
⇒ FDP050AN06AO	↔ FDP050AN06AO	⊛ FDP050AN06AO	⊣ FDP053N08B	↔ FDP053N08B_F102
↔ FDP054N10	⇒ FDP060AN08AO	D FDP060AN08AO	⊛ FDP060AN08AO	⊣ FDP060N08AO
⊛ FDP060N08AO	D FDP068AN08AO	⇒ FDP070AN06AO	↔ FDP070AN06AO	↔ FDP070AN06AO
⊣ FDP075N15A	⊛ FDP075N15A	↔ FDP083N15A	⇒ FDP083N15A	↔ FDP083N15A_F102
⊛ FDP085N10A	⊣ FDP085N10A	⊛ FDP085N10A_F102	D FDP090N10	↔ FDP090N10
↔ FDP100N10	⊛ FDP100N10	⊣ FDP10AN06AO	⊛ FDP10AN06AO	↔ FDP10AN06AO

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited